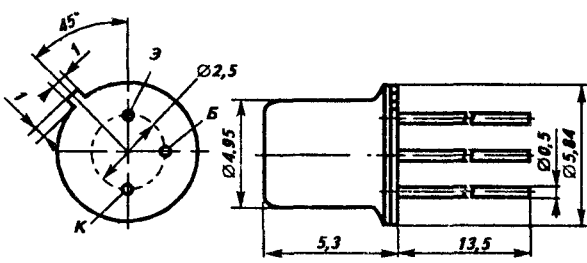


□ 2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В, 2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р. Предназначены для применения во вторичных источниках питания и в преобразователях. Выпускаются в металло-стеклянном корпусе, тип корпуса КТ-1-7. Масса транзистора не более 0,6 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В, I_к = 30 мА$, не менее:

$T = +25^{\circ}C$ 2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В	80
2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е	100
$T = +125^{\circ}C$ 2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В	80
2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е	100
$T = -60^{\circ}C$ 2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В	30
2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е	40

Граничная частота при $U_{кб} = 5 В, I_к = 30 мА$, не менее 50 МГц

Граничное напряжение при $I_к = 10 мА, t_n < 30 мкс, Q > 100$, не менее:

2Т3152А, 2Т3152Г	40 В
2Т3152Б, 2Т3152Д	30 В
2Т3152В, 2Т3152Е	20 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 300 мА, I_б = 60 мА$, не более 0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 300 мА, I_б = 60 мА$, не более 1,5 В

Время включения при $U_{кб} = 10 В, I_к = 300 мА, I_б = 60 мА, t_n < 30 мкс, Q > 100$, не более 0,1 мкс

Время выключения при $U_{кб} = 10 В, I_к = 300 мА, I_б = 60 мА, t_n < 30 мкс, Q > 100$, не более 0,5 мкс

Время рассасывания при $U_{кб} = 10 В, I_к = 300 мА, I_б = 60 мА, t_n < 30 мкс, Q > 100$, не более 0,4 мкс

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 20 В, f = 3 МГц$, не более:

2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В	35 пФ
2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е	60 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{кб} = 5 В, f = 3 МГц$, не более:

2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В	20 пФ
2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е	120 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{об} = 10 кОм$, не более:

$T = +25^{\circ}C$ 2Т3152А, 2Т3152Г при $U_{кб} = 50 В$	10 мкА
2Т3152А, 2Т3152Д при $U_{кб} = 40 В$	10 мкА
2Т3152Б, 2Т3152Е при $U_{кб} = 30 В$	10 мкА
$T = +125^{\circ}C$ 2Т3152А, 2Т3152Г при $U_{кб} = 50 В$	50 мкА
2Т3152Б, 2Т3152Д при $U_{кб} = 40 В$	50 мкА
2Т3152В, 2Т3152Е при $U_{кб} = 30 В$	50 мкА

Обратный ток эмиттера при $T = +25^{\circ}C$, не более:

2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В при $U_{кб} = 20 В$	100 мкА
2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е при $U_{кб} = 5 В$	100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

2Т3152А, 2Т3152Г	50 В
2Т3152Б, 2Т3152Д	40 В
2Т3152В, 2Т3152Е	30 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{об} = 10 кОм$

2Т3152А, 2Т3152Г	50 В
2Т3152Б, 2Т3152Д	40 В
2Т3152В, 2Т3152Е	30 В

Постоянное напряжение эмиттер-база

2Т3152А, 2Т3152Б, 2Т3152В	20 В
2Т3152Г, 2Т3152Д, 2Т3152Е	5 В

Постоянный ток коллектора

150 мА

Импульсный ток коллектора при $t_n < 1 мс, Q > 2$

300 мА

Постоянный ток базы

60 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при

$T = -60 +60^{\circ}C$

0,2 Вт

Температура р-п перехода

+150°C

Температура окружающей среды

-60°C +125°C

¹При $T = +60 +125^{\circ}C$ постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно на 2 мВт/°C

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником. Допустимое число перепаяк выводов транзисторов при проведении монтажных (сборочных) операций равно 3-м. Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба вывода не менее 3 мм. Расстояние от корпуса до места лужения и пайки по длине вывода не менее 3 мм.

